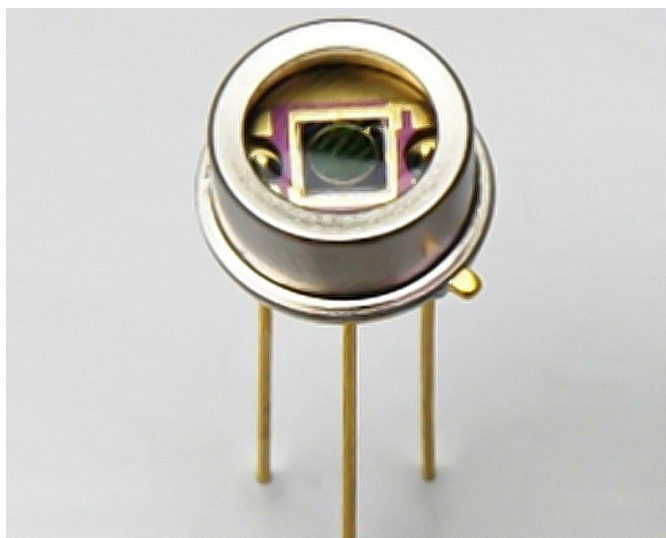


铟镓砷 InGaAs PIN光电二极管 $\phi 3\text{mm}$



产品描述:

InGaAs 光电二极管主要用于近红外探测，具有高速、高灵敏度、低噪音、宽广普响应范围 (0.5 μm to 2.6 μm) 等特点。

应用领域:

- ☀ 截止波长: 2.6 μm
- ☀ 低成本
- ☀ 感光面积: $\phi 3\text{ mm}$
- ☀ 低噪声
- ☀ 高灵敏度
- ☀ 高可靠性
- ☀ 高速响应

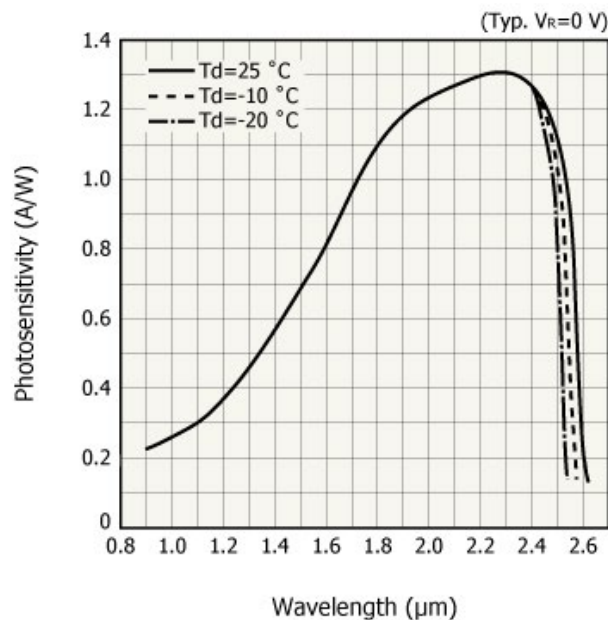
应用领域:

- ☀ 光功率计
- ☀ 气体分析
- ☀ 湿度计
- ☀ 近红外光度法

技术参数:

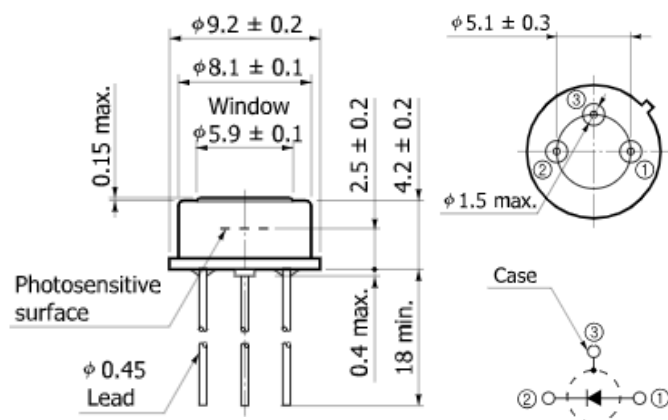
感光面积	φ3mm
像元个数	1
封装	Metal
封装类型	TO-5
制冷方式	Non-cooled
光谱响应范围	0.9 to 2.6 μm
峰值灵敏度波长(典型值)	2.3 μm
灵敏度(典型值)	1.3 A/W
暗电流(最大值)	100000 nA
截至频率(典型值)	0.8MHz
结电容(典型值)	4000 pF
噪声等效功率(典型值)	3×10^{-12} W/Hz ^{1/2}
测量条件	Typ. Ta=25 °C, unless otherwise noted, Photosensitivity: $\lambda = \lambda_p$, Dark current: VR=0.5 V, Cutoff frequency: VR=0 V, RL=50 Ω, Terminal capacitance: VR=0 V, f=1 MHz.

光谱响应:



KIRDB0491JC

外形尺寸 (单位: mm):



Distance from photosensitive
 area center to cap center
 $-0.2 \leq X \leq +0.2$
 $-0.2 \leq Y \leq +0.2$

KIRDA0221EA